

BRF10N60 (CS10N60F)

N-CHANNEL MOSFET/N 沟道 MOS 晶体管

用途：用于高功率 DC/DC 转换和功率开关。

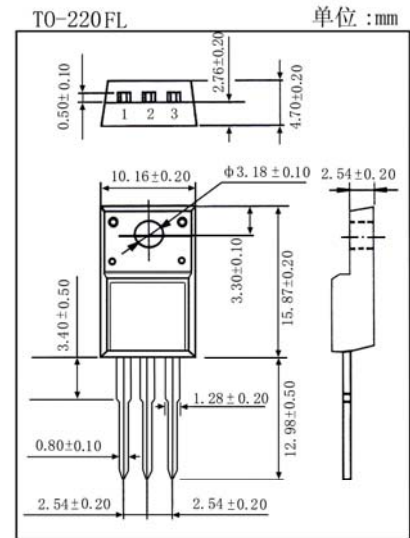
Purpose: These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters and switch mode power supplies.

特点：低栅电荷, 低反馈电容, 开关速度快。

Features: Low gate charge, low crss, fast switching.

极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V _{DSS}	600	V
I _D (Tc=25°C)	9.5	A
I _D (Tc=100°C)	5.7	A
I _{DM}	38	A
V _{GSS}	±20	V
E _{AS}	700	mJ
E _{AR}	15.6	mJ
I _{AR}	9.5	A
R _{θJC}	2.5	°C/W
R _{θJA}	62.5	°C/W
P _D (Tc=25°C)	50	W
T _J , T _{STG}	-55 to 150	°C



引脚： 1.G 2.D 3.S

电性能参数/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
BV _{DSS}	V _{GS} =0V I _D =250 μ A	600			V
I _{DSS}	V _{DS} =600V V _{GS} =0V			1.0	μ A
	V _{DS} =480V T _C =125°C			10	μ A
I _{GSS}	V _{GS} =±20V V _{DS} =0V			±10	μ A
V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} I _D =250 μ A	2.0		4.0	V
R _{DS(on)}	V _{GS} =10V I _D =4.75A		0.6	0.73	Ω
g _{FS}	V _{DS} =40V I _D =4.75A		8.0		S
V _{SD}	V _{GS} =0V I _S =9.5A			1.4	V
C _{iss}	V _{DS} =25V V _{GS} =0V f=1.0MHz		1570	2040	pF
C _{oss}			166	215	
C _{rss}			18	24	
t _{d(on)}	V _{DD} =300V I _D =9.5A R _C =25 Ω		23	55	ns
t _r			69	150	
t _{d(off)}			144	300	
t _f			77	165	

BRF10N60 (CS10N60F)

